

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成22年1月21日 (2010.1.21)

【公開番号】特開2002-314020(P2002-314020A)  
 【公開日】平成14年10月25日 (2002.10.25)  
 【出願番号】特願2001-112218(P2001-112218)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/50 (2006.01)

C 2 5 D 7/12 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 23/50 D

C 2 5 D 7/12

【手続補正書】

【提出日】平成21年11月18日 (2009.11.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体パッケージを形成するリードフレームにワイヤーボンディングのために必要な金属めっきを施す製版めっき方法において、リードフレーム全体にフォトレジストのレジスト膜を形成した後、まず先に裏面のみを全面露光し、次いで表面のパターン露光を行ってから、現像、金属めっき、レジスト剥離を行う工程を含むことを特徴とするリードフレームの製版めっき方法。

【請求項 2】 リードフレーム全体にフォトレジストのレジスト膜を形成した後、裏面を全面露光し、次いで表面のパターン露光を行ってから、現像、金属めっき、レジスト剥離を行う工程を含む製版めっき方法により、ワイヤーボンディングのために必要な金属めっきを施したリードフレームを得ることを特徴とするリードフレームの製造方法。

【請求項 3】 リードフレーム全体にフォトレジストのレジスト膜を形成した後、裏面を全面露光し、次いで表面のパターン露光を行ってから、現像、金属めっき、レジスト剥離を行う工程を含む製版めっき方法により、ワイヤーボンディングのために必要な金属めっきを施し、次いで、このように加工したリードフレームに対して半導体素子をダイボンディングし、ワイヤーボンディングを行った後、樹脂による一括モールドを行い、この樹脂モールドの後、ダイシングにより個片化することにより半導体パッケージを得ることを特徴とする半導体パッケージの製造方法。

【請求項 4】 得られる半導体パッケージが QFN 型であることを特徴とする請求項 3 に記載の半導体パッケージの製造方法。